

文件制修訂記錄

[illegible]

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 1 / 9 頁

一、目的：

定義 8 吋高密度化學氣相沉積系統生產操作規範，以確保設備生產操作品質。

二、適用範圍：

適用於 8 吋高密度化學氣相沉積系統。

三、權責：

1. 組織權責：製程人員負責制定及修改規範。
2. 設備負責人負責機台的異常處理，維持生產正常運轉。
3. 執行人員資格：經過 8 吋高密度化學氣相沉積系統考核通過之人員。

四、相關文件：

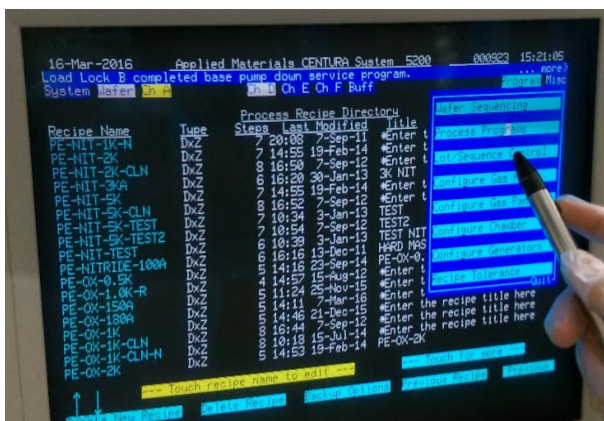
8 吋高密度化學氣相沉積系統 Operation manual。

五、標準操作程序：

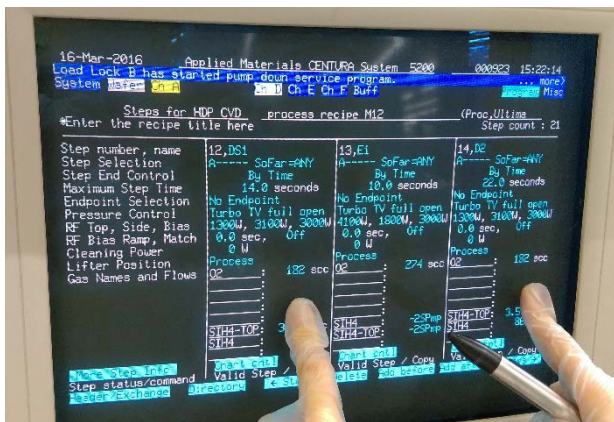
1、 Auto Process (run 貨)

(1) Check Recipe

操作順序：Program → Process Program → Steps (Check main step)

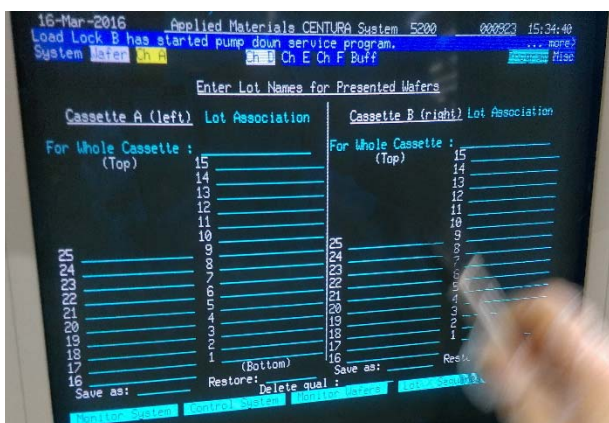
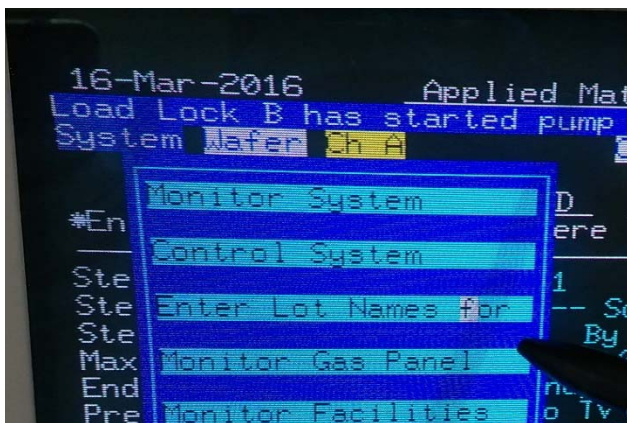


NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 2 / 9 頁

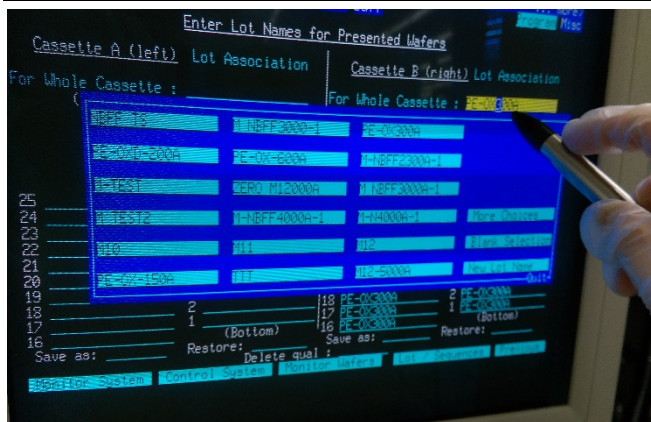


(2).設定製程程序

操作順序：System → Enter Lot Names for → For Whole Cassette or Slot 1~25



NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 3 / 9 頁



(3).執行製程程序

操作順序：Wafer → Load / Unload(破真空) → 放晶片至 Load Lock →
Run (Go) → Load / Unload



(4).回到主畫面

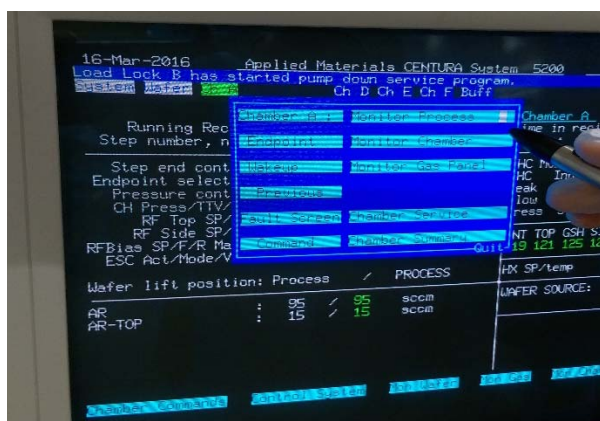
操作順序：Wafer → Wafer Monitor

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 4 / 9 頁

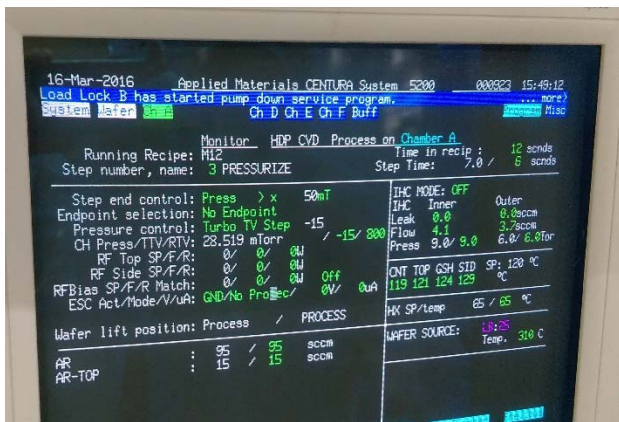


(5).觀看製程程序細節

操作順序：Ch A → Monitor Process



NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 5 / 9 頁



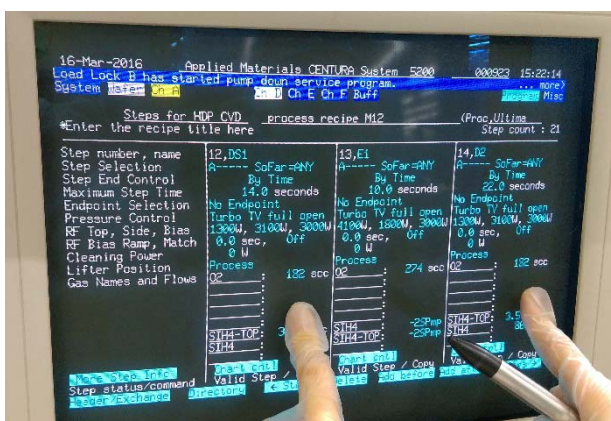
(6) 完成製程程序操作

操作順序：Wafer → Load / Unload(破真空) → 取出晶片

2、 Manual Process (run 貨)

(1) Check Recipe

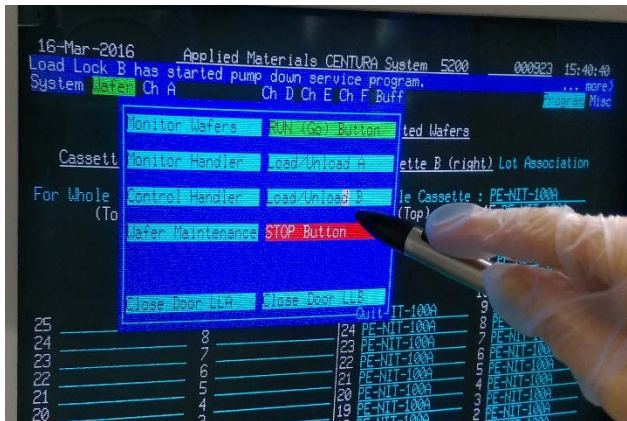
操作順序：Program → Process Program → Steps (Check main step)



(2) 執行 Mapping 程序

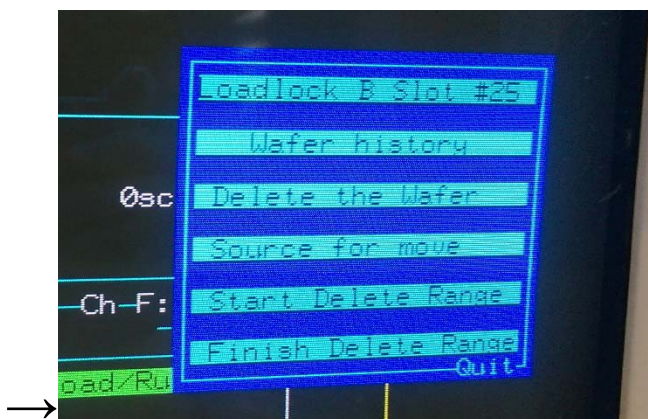
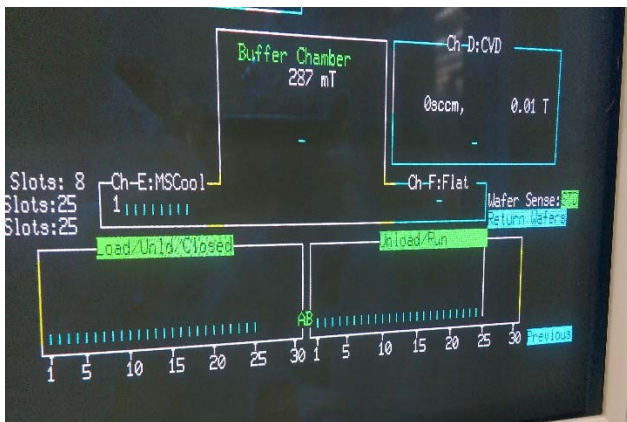
NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 6 / 9 頁

操作順序：Wafer → Load / Unload(破真空) → 放晶片至 Load Lock →
Load / Unload

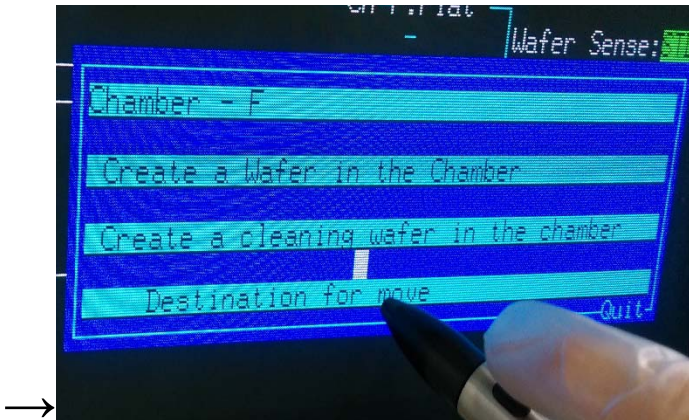


(3)傳送程序(LL → ChF → ChA)

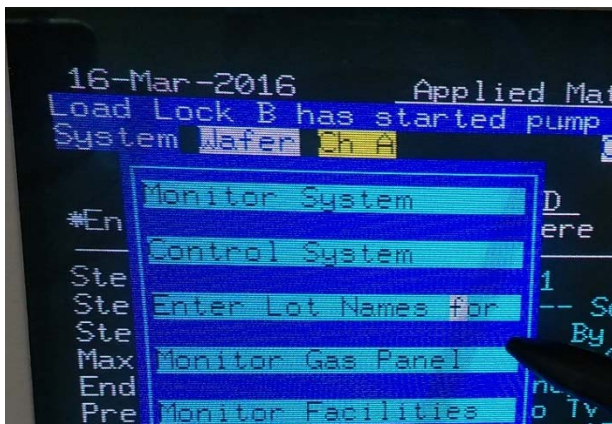
操作順序：選取 Wafer → Source for Move (圖示會閃爍) → 點選 Ch-F : Flat →
Destination for move(將傳送到 ChF) → Run ChF Process →
選取 ChF Wafer → Source for Move (圖示會閃爍) → 點選 Ch-A
Destination for move(將傳送到 ChA)



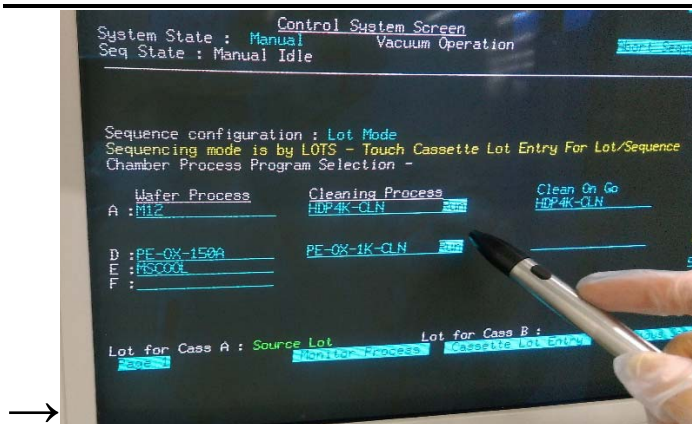
NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 7 / 9 頁



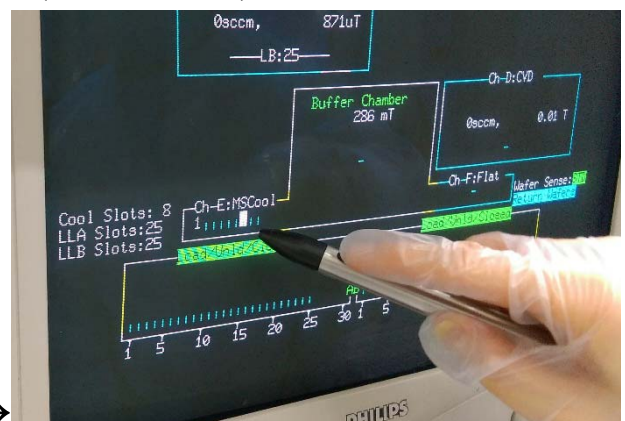
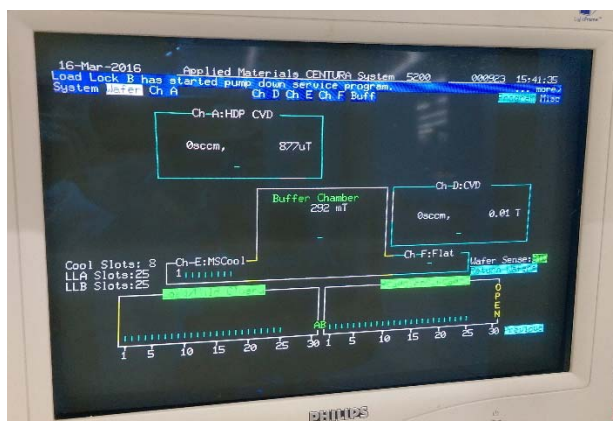
System → Control System → Run ChA Wafer Process or Clean



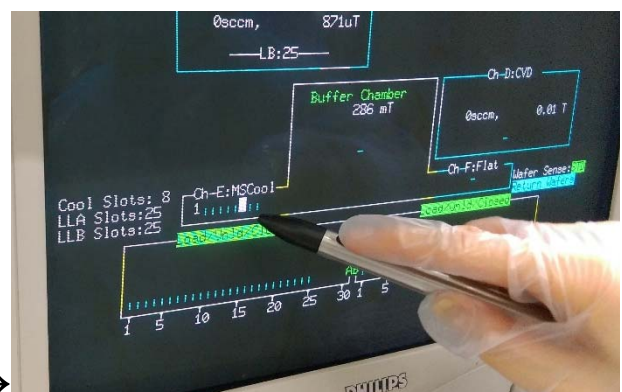
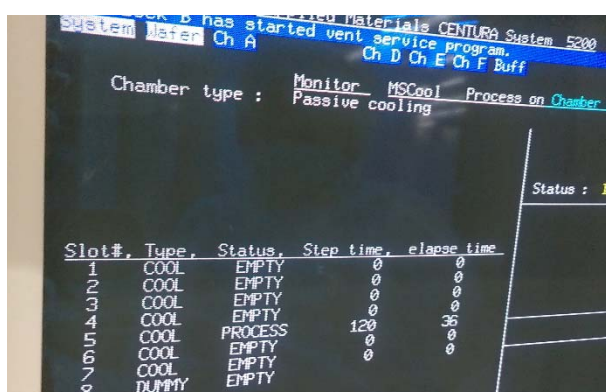
NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 8 / 9 頁



完成後選取 ChA Wafer → Source for Move (圖示會閃爍) →
 點選 Ch-E → Destination for move(將傳送到 ChE) →

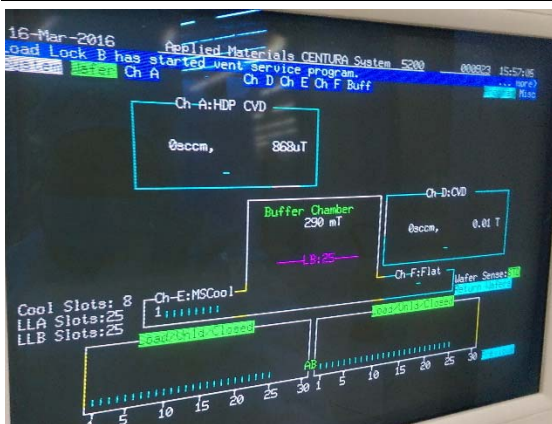


17.Auto Run ChE Process → 18.完成後選取 ChE Wafer →



Source for Move (圖示會閃爍) → 點選 LL 與 Slot →
 Destination for move(將傳送到 LL) →

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T28 8 吋高密度化學氣相沉積系統)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 9 / 9 頁



3、完成手動製程程序操作

操作順序：Wafer → Load / Unload(破真空) → 取出晶片

六、注意事項：

1. 如遇異常狀況無法判定及處理時，請立即通知機台負責人。
2. 使用機台時，必須參照機台標準作業程序與遵守機台相關規定。

七、應用表單及附件：

1. Q4-NL02 設備管理卡
2. Q4-NL03 設備考核表
3. Q4-NL04 設備點檢表
4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單

1.